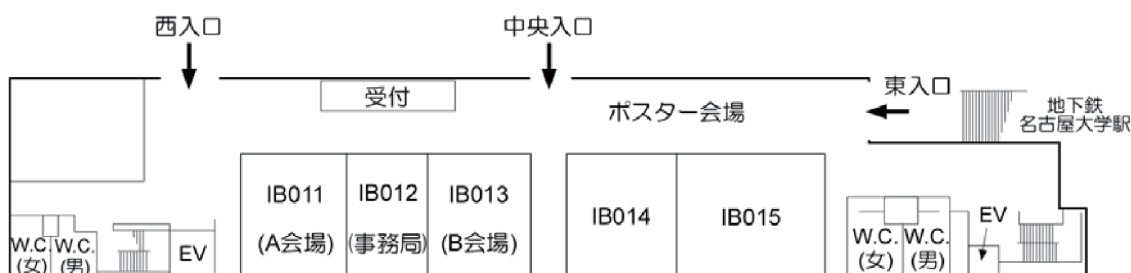


タイムスケジュール

時刻	スケジュール	IB011 (A 会場)	IB013 (B 会場)	IB 館廊下
10:00~11:00	ポスター発表①			奇数番号の発表
11:00~12:00	ポスター発表②			偶数番号の発表
12:10~13:30	ランチ懇親会			
13:45~14:00	口頭発表①	A1	B1	
14:00~14:15		A2	B2	
14:15~14:30		A3	B3	
14:30~14:45	休憩			
14:45~15:00	口頭発表②	A4	B4	
15:00~15:15		A5	B5	

会場図



プログラム

10:00~12:00 ポスターセッション

会場(IB 館廊下)

10:00~11:00 奇数番号の発表者

11:00~12:00 偶数番号の発表者

P1 水から受ける抵抗力と物体の終端速度の関係

愛知県立岡崎高等学校スーパーサイエンス部 佐藤良祐

P2 ラジカル照射されたツチアオカビによるセルラーゼ分泌促進

名城大学¹, 名古屋大学² °出口貴大¹, 志水元亨¹, 加藤雅士¹, 堀勝², 伊藤昌文¹

P3 磁性半導体候補物質磁性半導体候補物質(Ba,X)(Zn,Mn)2P2 (X = K, La)の気磁及び輸送特性

名大工 °廣瀬翔一, 伊藤巧, 浦田隆広, 畑野敬史, 飯田和昌, 生田博志

P4 ラジカル処理フェニルアラニン溶液を用いた植物生長促進

名城大学¹, 名古屋大学² °伊藤銀二¹, 岩田直幸¹, 橋爪博司², 堀勝², 伊藤昌文¹

- P5 レーザービームをエネルギー源とする宇宙輸送機への応用に向けたクリプトンレーザー維持プラズマの生成実験
静岡大学¹, 名古屋大学² °亀井知己¹, 丹羽亮貴, 石川知義, 松井信, 森浩一²
- P6 メラノーマ細胞におけるラジカル活性乳酸リンゲル液の不活性効果
名城大学¹, 名古屋大学² °(M1)堀侑己¹, 村田富保¹, 堀勝², 伊藤昌文¹
- P7 シングルバブルソノルミネセンス発光時間幅溶存気体依存性
静岡大学¹ °原涼馬¹, 松井信¹
- P8 出芽酵母細胞に対する紫外光照射の影響
名城大学¹, 名古屋大学² °伊藤翔磨¹, 橋爪博司², 堀勝², 伊藤昌文¹
- P9 一方向配向 CNT/エポキシ樹脂複合材料の諸特性における CNT 直径の影響
静大院工 °露口陽平, 中野貴之, 井上翼
- P10 X線マイクロビーム回折を用いた単一 Ga_{1-x}In_xN/GaN 量子殻の局所構造評価
名城大理工¹, 高輝度光科学研究センター², 名大未来材料・システム研³ °市川貴登¹, 近藤剣¹, 安田信広², 隅谷和嗣², 今井康彦², 中尾知代³, 荒井重勇³, 後藤七美¹, 上山智¹, 今井大地¹, 宮嶋孝夫¹
- P11 乾式紡績に向けた酸化鉄ナノ粒子を用いた高密度 SWCNT フォレスト合成
静大工 °後藤良輔, 田畑良篤, 中野貴之, 井上翼
- P12 フェムト秒レーザー照射によるグラファイト板表面の濡れ性制御
名古屋工業大学¹, 株式会社タマリ工業², °田中良樹¹, 伊藤広朗¹, 三瓶和久², 滝沢宣人², 糸魚川文広¹, 小野晋吾¹
- P13 熱交換型レーザー推進デモ機の熱流体解析
静大工¹, 名大工², °丹羽亮貴¹, 亀井知己¹, 石川知義¹, 松井信¹, 森浩一²
- P14 ミスト CVD による酸化亜鉛薄膜合成に対する大気圧ラジカル源のアシスト効果
名城大学 °可児旭, 竹田圭吾, 平松美根男
- P15 浮遊触媒 CVD 法によるアルミホイル上への CNT フォレスト合成
静大院工 °宮本将, 中野貴之, 井上翼
- P16 水溶液蒸発法で結晶成長した RbNaSO₄ の熱的及び X 線的研究
中部大学 °吉川侑里, 栗濱忠司
- P17 金属薄膜酸化法による Al₂O₃/4H-SiC(0001)界面特性の改善
名大院工¹, 産総研・名大 GaN-OIL², 愛知工大³ °土井拓馬^{1,2}, 柴山茂久¹, 竹内和歌奈^{1,3}, 坂下満男¹, 田岡紀之¹, 清水三聡², 中塚理¹
- P18 酸素ラジカル照射における支持脂質二重膜上の液相厚が及ぼす膜内側方拡散係数への影響
名城大学¹, 豊橋技科大², 名大³ °(M1)飯尾望¹, 久米寛¹, 手老龍吾², 堀勝³, 伊藤昌文¹
- P19 SiC_xO_y 界面層導入による金属/4H-SiC コンタクトの SBH 制御 Control
名大院工¹, 名古屋大未来研² °橋本健太郎¹, 土井拓馬¹, 柴山茂久¹, 中塚理^{1,2}
- P20 光源の自己吸収効果を用いた真空紫外吸収分光法
名城大理工¹, 名古屋大学² °(M2)清水奨¹, 竹田圭吾¹, 堤隆嘉², 平松美根男¹, 堀勝²
- P21 導電性原子間力顕微鏡により評価した p 型単結晶 Si 太陽電池セル表面における電圧誘起劣化加速試験の影響
岐阜大工 °(M2)古谷大志, 大橋史隆, 傍島靖, 吉田憲充, 野々村修一
- P22 ミリ波分光観測装置における多周波同時観測システムの開発
名古屋大学大学院工学研究科¹, 名古屋大学宇宙地球環境研究所², 山梨大学工学部³ °小瀬垣貴彦^{1,2}, 中島拓^{1,2}, 水野亮², 長濱智生², 林拓磨³, 關谷尚人³

P23 CH₃NH₃PbI_{3-x}Cl_x 薄膜における欠陥評価のための 光熱輻射分光法による光吸収係数測定

岐阜大工 °(M2)山田航太郎, 菅沼将也, 廣田雄大, 傍島靖, 吉田憲充

12:10~13:30 ランチ懇親会

13:45~15:15 オーラルセッション (A 会場: IB011, B 会場: IB013)

A 会場(IB011)

13:45~14:30 オーラルセッション A1~A3

13:45~14:00 **A1** トポロジカル絶縁体 Bi₂Se₃ と鉄系超伝導体 NdFeAs(O,F)の接合デバイス作製にむけた加工プロセスの検討

名大工 °伊東直輝, 辻康成, 近藤圭祐, 畑野敬史, 飯田和昌, 生田博志

14:00~14:15 **A2** Nd 置換 CeOBiS₂ 単結晶の育成および特性評価

山梨大¹, 物材機構² °(M2)花田祐二¹, 長尾雅則¹, 丸山祐樹¹, 綿打敏司¹, 高野義彦², 田中功¹

14:15~14:30 **A3** トポタクティック反応を用いた NdFeAs(O,H)エピタキシャル薄膜の作製

名大工¹, JST CREST² °近藤圭祐¹, 本木聖也¹, 畑野敬史¹, 飯田和昌^{1,2}, 生田博志¹

14:30~14:45 休憩

14:45~15:15 オーラルセッション A4, A5

14:45~15:00 **A4** NdFeAsO 系超伝導薄膜の細線加工及び輸送特性評価

名大工¹, 産総研ナノエレクトロニクス研究部門² °(M2)辻泰成¹, (M1)近藤圭祐¹, 畑野敬史¹, 飯田和昌¹, 全伸幸², 馬渡康徳², 生田博志¹

15:00~15:15 **A5** フェムト秒レーザー加工による THz 帯モスアイ構造の断面形状制御

名工大¹, 株式会社タマリ工業² °余希¹, 田中良樹¹, 滝沢宣人², 三瓶和久², 裴鐘石¹, 小野 晋吾¹

B 会場(IB013)

13:45~14:30 オーラルセッション B1~B3

13:45~14:00 **B1** ポリウレタン複合薄膜におけるプラズマ処理をした カーボンナノチューブの濃度依存性

中部大工¹ °松尾虹汰¹, 坂井田怜¹, 花田聖季也¹, 小川大輔¹, 中村圭二¹

14:00~14:15 **B2** 反強磁性体 CaMn₂Bi₂ における整流効果

名大院工 竹内啓喜, 浦田隆広, 生田博志

14:15~14:30 **B3** イオン注入歪み緩和法による SiGe/Si(110)ヘテロ構造の作製

山梨大¹, 東京都市大² °大島佑介¹, 大木健司², マハフーズアラム², 澤野憲太郎², 有元圭介¹, 山中淳二¹, 原康祐¹, 中川清和¹

14:30~14:45 休憩

14:45~15:15 オーラルセッション B4, B5

14:45~15:00 **B4** 酸素ラジカル照射トリプトファン含有リン酸緩衝液溶液中の大腸菌殺菌効果

名城大理工¹, 名古屋大工², 大阪市大工³ °(M2)岩田直幸¹, 伊藤銀二¹, ウラディ斯拉フ・ガマリェエフ¹, 橋爪博司², 吳準席³, 石川健治², 堀勝², 伊藤昌文¹

15:00~15:15 **B5** B 添加 Ge コア Si 量子ドットの PL 特性評価

名大院工 °前原拓哉, 藤森俊太郎, 池田弥央, 大田晃生, 牧原克典, 宮崎誠一